

ISS196

SWITCHING DIODE 開關二極管

■ FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	PD(Ta=25°C)	225	mW
Forward Current 正向電流	I _F	200	mA
Reverse Voltage 反向電壓	V _R	80	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度	T _J , T _{stg}	-55 to +150°C	

■ DEVICE MARKING 打標

ISS196=G3

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(T_A=25°C unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 (I _R =100uA)	V _(BR)	80	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 (V _R =80V)	I _R	—	0.5	uA
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 I _F =1mA I _F =10mA I _F =50mA I _F =150mA	V _F		715 855 1000 1250	mV
Diode Capacitance 二極體電容 (V _R =0V, f=1MHz)	C _D	—	1.5	pF
Reverse Recovery Time 反向恢復時間	T _{rr}	—	4	nS

■ SOT-23 內部結構

